Ürün kataloğu

LDMOS güç yükselteçleri

LDMOS güç yükselteçleri, yanal difüzyonlu MOS transistörlerle RF gücünü artırır. Uyumlama, kutuplama, sinyal tepeleri ve tüm ısı yolu çalışma sınırlarını belirler.

Ürünler: 2

Revizyon: 2 · Revizyon tarihi: 2026-11-11





LCPAM-20-520-200A

20–520 MHz 200 W doyum çıkışlı LDMOS RF güç yükselteci modülü

LDMOS son katlı modül, 20–520 MHz bandını 200 W tipik doyum çıkışıyla kapsar. 1 dB sıkışma noktasındaki çıkış ayrı olarak tipik 50 W, küçük sinyal kazancı tipik 53 dB olarak belirtilir.

Çalışma frekansı: Sembol: BW; Minimum: 20; Maksimum: 520; Birim: MHz

Doyum RF çıkış gücü: Sembol: Psat; Tipik: 200; Birim: W

1 dB sıkışma noktasında çıkış gücü: Sembol: P1dB; Tipik: 50; Birim: W

Küçük sinyal kazancı: Sembol: G; Tipik: 53; Birim: dB

25 °C; 50 Ω

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCPAM-20-520-350

20–520 MHz LDMOS RF güç yükselteci, tipik 350 W doygun çıkış

LDMOS yükselteç 20–520 MHz bandında tipik 350 W doygun çıkış ve 1 dB sıkışmada 150 W çıkış sağlar. Tipik kazanç 56 dB, 350 W'ta akım 29 A ve besleme 48 VDC'dir.

Çalışma frekansı: Sembol: BW; Minimum: 20; Maksimum: 520; Birim: MHz

1 dB sıkışma noktasında çıkış gücü: Sembol: P-1dB; Tipik: 150; Birim: W

RF çıkış gücü @ PSAT: Sembol: PSAT; Tipik: 350; Birim: W

Güç kazancı @ PSAT: Sembol: Gp; Tipik: 56; Birim: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.